

# SIMSによる極浅注入プロファイルの評価

極浅い領域においてもドーパント分布・接合の評価が可能

測定法 : SIMS  
 製品分野 : LSI・メモリ  
 分析目的 : 微量濃度評価

## 概要

デバイスの微細化により、極浅い領域における不純物の深さ方向分布評価の必要性が高まっています。正確な評価を行うためには、通常よりも低いエネルギー(1keV以下)の一次イオンビームを用いたSIMS分析が必要になります。図1にBF<sub>2</sub><sup>+</sup> 1keV, P<sup>+</sup> 1keV, As<sup>+</sup> 1keVで注入されたSiウエハを一次イオンビームエネルギー 250eV~300eVを用いて測定した例を示します。

## データ

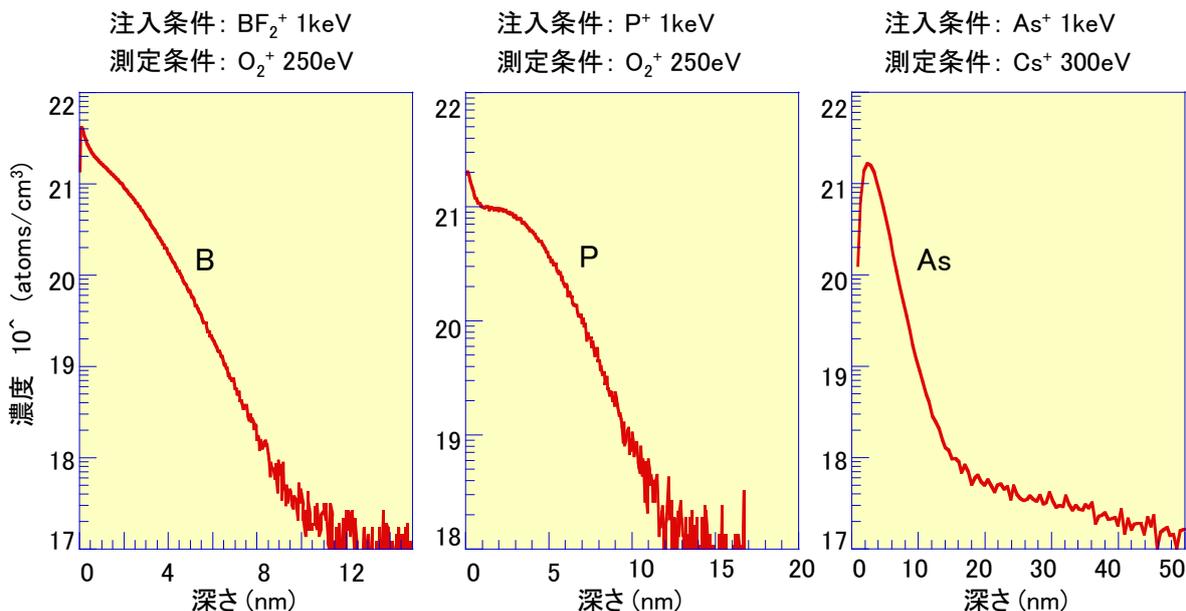


図1 極浅注入プロファイル評価

分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート！

一般財団法人  
**MIST** 材料科学技術振興財団

TEL : 03-3749-2525 E-mail : info@mst.or.jp  
 URL : <https://www.mst.or.jp/>